






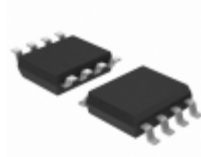


	<p>SI9926BDY-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI9926BDY-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 20V 6.2A 8-SOIC</p>
	<p>Datenblätter:  SI9926BDY-T1-GE3.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 20000 pcs Stock Available.</p>
	<p>Lieferrn von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI9926BDY-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 20V 6.2A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	20000 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 20V 6.2A 1.14W
Serie	TrenchFET®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	1.14W
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.2A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	20 mOhm @ 8.2A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Basisteilenummer	SI9926
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

SI9926BDY-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI9926BDY-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI9926BDY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI9926BDY-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI9926BDY-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET 2N-CH 20V 6.2A 8-SOIC</p>	 <p>SI9926ADY-T1-GE3 VISHAY SI9926ADY-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p>SI9926BE VISHAY VISHAY SOP8</p>	 <p>SI9926CDY-T1 VISHAY VISHAY SO-8</p>
 <p>SI9926C KEXIN SI9926C KEXIN</p>	 <p>SI9926BDY-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET 2N-CH 20V 6.2A 8-SOIC</p>	 <p>SI9926BDY-T1-E3. Vishay Precision Group SI9926BDY-T1-E3. VISHAY</p>	 <p>SI9926BDY SI SI9926BDY SI</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ⚙ SI9706DY-T1 | ↔ SI9706DY-T1-E3 | ➔ SI9706DY-T1-E3 | D SI9710CY | ➔ SI9711CY |
| ⊣ SI9711CY-T1-E3 | ⚙ SI9712DY | D SI9712DY-T1 | ➔ SI9712DY-T1-E3 | ➔ SI9712DY-T1-E3 |
| ⚙ SI9712DY-T1 | ⊣ SI9717CY | ⚙ SI9731DQ-T1 | ↔ SI9731DQ-T1-E3 | ➔ SI9731DQ-T1-E3 |
| D SI9925DY | ⚙ SI9925DY-T1 | ⊣ SI9925DY-T1-E3 | ⚙ SI9926-3 | ➔ SI9926ADY |
| ➔ SI9926ADY-T1 | ↔ SI9926ADY-T1-E3 | ⚙ SI9926ADY-T1-GE3 | ⊣ SI9926BDY-T1-E3 | ➔ SI9926BDY-T1-E3 |
| ↔ SI9926BDY-T1-GE3 | ➔ SI9926CDY | D SI9926CDY-T1-E3 | ⚙ SI9926CDY-T1-E3 | ⊣ SI9926CDY-T1-GE3 |
| ⚙ SI9926CDY-T1-GE3 | D SI9926DY | ➔ SI9926DY-T1 | ↔ SI9926DY-T1-E3 | ➔ SI9926DY-T1-GE3 |
| ⊣ SI9928DY-T1 | ⚙ SI9928DY-T1-E3 | ↔ SI9933ADY-T1 | ➔ SI9933ADY-T1-E3 | ➔ SI9933ADY-T1-E3. |
| ⚙ SI9933ADY-T1-E3.. | ⊣ SI9933BDY | ⚙ SI9933BDY-T1-E3 | D SI9933BDY-T1-E3 | ➔ SI9933BDY-TI-E3 |
| ↔ SI9933CDY | ⚙ SI9933CDY-T1-E3 | ⊣ SI9933CDY-T1-E3 | ⚙ SI9933CDY-T1-GE3 | ➔ SI9933CDY-T1-GE3 |

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited